

高知工科大学ナノテク研シンポジウム 2012

日時： 2012 年 11 月 17 日（土） 10:00～17:00

場所： 高知工科大学 C 棟 1F C-102 （〒782-8502 高知県香美市土佐山田町宮ノ口 185）

主催： 高知工科大学ナノテクノロジー研究所

共催： 応用物理学会中国・四国支部，協賛： 日本金属学会中四国支部

参加費： 無料，申込： 参加申し込みは不要（直接会場にお越し下さい）

ープログラムー

開会の挨拶 高知工科大学 ナノテクノロジー研究所 所長 八田章光

座長： 古田 守

10:00～10:20 「ミスト CVD 法による酸化アルミニウム薄膜の低温成長への挑戦」

内田貴之，川原村敏幸，古田 守，眞田 克（高知工科大学）

10:20～10:40 「Influence of Substrate on Zinc Oxide Nanostructures Grown by Thermal Annealing」

Xin Li, Chaoyang Li, Toshiyuki Kawaharamura, Dapeng Wang, Mamoru Furuta,
Akimitsu Hatta (Kochi University of Technology)

10:40～11:00 「球状多孔質二酸化チタンナノ粒子のワンポット単工程合成とその応用」

横山和哉，王 鵬宇，小廣和哉（高知工科大学）

11:00～11:10 休憩

11:10～11:30 「ナノ結晶欠陥導入による希土類系高温超伝導薄膜の高性能化」

藤田夏斗^a，春田正和^a，一瀬 中^b，前田敏彦^a，堀井 滋^a
（^a高知工科大学，^b電力中央研究所）

11:30～11:50 TEM 活用基礎講座（高知工科大学新田）

11:50～13:00 休憩

座長： 八田章光

13:00～14:00 基調講演「電子照射・励起誘起相転移の電顕内その場観察」

大阪大学 超高压電子顕微鏡センター 保田英洋教授

14:00～14:10 休憩

14:10～15:10 特別講演「半導体デバイスの不良解析における STEM の活用」

ルネサスエレクトロニクス株式会社 生産本部
デバイス・解析技術統括部 製品解析技術部 為我井晴子氏

15:10～15:20 休憩

座長： 川原村敏幸

15:20～15:35 「重合性液晶を用いた光駆動素子の開発」

伊藤基巳紀，古沢 浩，木村正廣（高知工科大学）

15:35～15:55 「イオンビームを照射したポリイミド表面での液晶配向に関する研究」

福井博之，寺内 晃，前田一樹，加藤広基，橋本泰圭，百田佐多生，富山皓史，
辻 知宏，蝶野成臣（高知工科大学）

15:55～16:15 「カーボンナノチューブ触媒技術」

小路紘史，関家一樹，松本康平，針谷 達，新田紀子，古田 寛，八田章光
（高知工科大学）

閉会の挨拶 高知工科大学 研究本部長 木村 良

16:30～17:00 ナノテクノロジー研究所 施設見学（講演者・学外参加者対象）

（発表時間は討論時間を含む）

連絡・問合せ先： 高知工科大学 ナノテクノロジー研究所 新田紀子

Tel: 0887-57-2775 (ex. 3682), e-mail: nitta.noriko@kochi-tech.ac.jp